Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0108U004560

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 24-04-2008

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 600 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442878922, 0442878922

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Фізичні механізми впливу деформаційних полів на самоорганізоване формування напівпровідникових наноструктур і варіювання цих полів для керування характеристиками наноструктур

Назва роботи англійською:

The physical mechanism of the influence on self-organize formation of semiconductor structure and their for a Фізичні механізми впливу деформаційних полів на самоорганізоване формування напівпровідникових наноструктур і варіювання цих полів для керування характеристиками наноструктур

Мета роботи українською:

Метою проекту є теоретичне та експериментальне дослідження фізичних процесів, викликаних деформаційними полями, в реальній діаграмі склад-структура-якість на ростових і пострестових технологічних етапах отримання наноструктур, в тому числі і з самоорганізованими квантовими точками (дротами).

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Встановлення взаємозв'язку параметрів полів механічних напружень зі структурними і оптичними властивостями наноструктур з метою оптимізації технологічних режимів формування структур із заданими характеристиками. Рекомендації по вирощуванню наноструктур певної форми, складу та щільності.

Галузь застосування:

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Валах Михайло Якович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор, член-кор.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розвиток методу молекулярно-променевої епітаксії та опрацювання технології отримання нанорозмірних шарів та наноструктур SiGe

Початок етапу: 05.2007

Закінчення етапу: 12.2008

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 535;539.183/.184;681.7;77, 535.375.5; 538.94

Коди тематичних рубрик: 29.31

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Мачулін Володимир Федорович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.